

Li_{1,44}Al_{1,44}Si_{1,56}O₆

Mohsen Graia,* Regaya Ksiksi et Ahmed Driss

Laboratoire de Matériaux et Cristallochimie,
 Faculté des Sciences de Tunis, Université de
 Tunis El Manar II, 2092 Tunis, Tunisie

Correspondence e-mail:
 mohseng2002@yahoo.fr

Key indicators

Single-crystal X-ray study
 $T = 298\text{ K}$
 Mean $\sigma()$ = 0.000 Å
 Disorder in main residue
 R factor = 0.017
 wR factor = 0.051
 Data-to-parameter ratio = 10.3

For details of how these key indicators were automatically derived from the article, see <http://journals.iucr.org/e>.

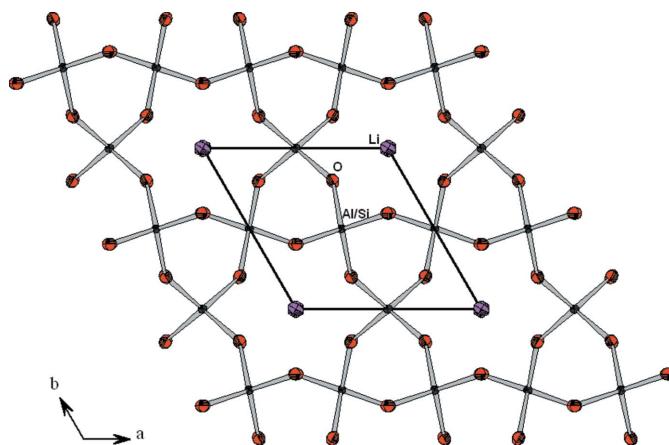
The title compound, lithium aluminium silicon hexoxide, was prepared by a solid-state method. It has the β -quartz-type structure. Si⁴⁺ cations are replaced by Al³⁺ and the charge is compensated by the incorporation of Li⁺ into the main channel of the structure. The Al and Si atoms are disordered on a single site.

Reçu le 17 octobre 2006
 Accepté le 27 novembre 2006

Commentaire

Les aluminosilicates du système Li₂O–Al₂O₃–SiO₂ (LAS) et, en particulier, les composés dérivés du quartz appartenant au pseudo-binaire LiAlSiO₄–SiO₂ constituent l'une des familles principales des matériaux (Beall, 1994). Ces composés sont caractérisés par une conductivité ionique fortement anisotrope dûe au transport d'ions Li⁺ le long de la direction de l'axe c (Qi *et al.*, 2004; Sartbaeva *et al.*, 2004; Shin-ichi *et al.*, 2004). En plus, ils présentent un faible coefficient de dilatation thermique (Xu *et al.*, 2000; Sprengard *et al.*, 2000). La transformation de la variété SiO₂- β (stable entre 846 K et 1143 K) en la variété basse température du quartz SiO₂- α est une transition displacive (Xu *et al.*, 1999, 2000; Sartbaeva *et al.*, 2004). SiO₂- β a pu être stabilisé à températures inférieures à 846 K par incorporation de Li dans une structure ôte (Beall, 1994; Lichtenstein *et al.*, 1998). L'eucryptite (LiAlSiO₄- β) est une superstructure de SiO₂- β . Sa périodicité de translation est doublée le long de a et de c relativement au quartz- β .

L'étude structurale du composé Li_{1,44}Al_{1,44}Si_{1,56}O₆ a révélé que sa structure est de type quartz- β . Dans cette structure, chacun des tétraèdres TO_4 (T = Si, Al) partage ses quatre sommets oxygène avec quatre tétraèdres adjacents voisins. La charpente tridimensionnelle ainsi constituée est caractérisée par des canaux larges parallèles à l'axe c . Ces derniers sont

**Figure 1**

Projection selon c de la structure du composé Li_{1,44}Al_{1,44}Si_{1,56}O₆. Les ellipsoïdes d'agitation thermique ont 50% de probabilité d'existance.

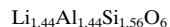
délimités par des doubles chaînes de tétraèdres hélicoïdales, de symétrie 6_2 , de période 6 et progressant dans la même direction c . Dans ces canaux sont logés les ions Li^+ qui compensent le défaut de charge dûe à la substitution de Si^{4+} par Al^{3+} . Les distances $T-\text{O}$ dans le composé $\text{Li}_{1.44}\text{Al}_{1.44}\text{Si}_{1.56}\text{O}_6$ sont comprises entre les distances moyennes $\text{Si}-\text{O}$ et $\text{Al}-\text{O}$ tétraédriques (*International Tables for Crystallography*, 1992).

Bien que des études antérieures suggèrent que la phase stable des composés $\text{Li}_x\text{Al}_x\text{Si}_{3-x}\text{O}_6$ pour $x > 1,05$ est de type eucryptite- β (Xu *et al.*, 2000), le composé étudié ($x = 1,44$) est de type quartz- β . Ce résultat est confirmé par la distance $T-\text{O}$ et le volume de la maille qui sont supérieurs à ceux de tous les composés isotypes déjà étudiés et qui correspondent à des valeurs de $x < 1,44$ (Tscherry *et al.*, 1972; Mueller *et al.*, 1990; Xu *et al.*, 1999).

Partie expérimentale

Le composé $\text{Li}_{1.44}\text{Al}_{1.44}\text{Si}_{1.56}\text{O}_6$ était obtenu par réaction à l'état solide à 1273 K lors d'une exploration du système $\text{Al}_2\text{O}_3\text{--Ce}_2\text{O}_3\text{--Li}_2\text{O}$. Le silicium est diffusé du creuset en porcelaine.

Données cristallines



$$M_r = 188,67$$

Hexagone, $P\bar{6}_22$

$$a = 5,2654 (2) \text{\AA}$$

$$c = 5,6240 (8) \text{\AA}$$

$$V = 135,03 (2) \text{\AA}^3$$

$$Z = 1$$

$$D_x = 2,320 \text{ Mg m}^{-3}$$

Mo $K\alpha$ radiation

Paramètres de la maille à l'aide de 25 réflexions

$$\theta = 11,5\text{--}20,2^\circ$$

$$\mu = 0,75 \text{ mm}^{-1}$$

$$T = 298 (2) \text{ K}$$

Prisme, incolore

$$0,15 \times 0,12 \times 0,06 \text{ mm}$$

Collection des données

Diffractomètre Enraf-Nonius CAD-4

Balance $\omega/2\theta$

Correction d'absorption: ψ scan (North *et al.*, 1968)

$$T_{\min} = 0,894, T_{\max} = 0,959$$

876 réflexions mesurées

134 réflexions indépendantes

127 réflexions avec $I > 2\sigma(I)$

$$R_{\text{int}} = 0,049$$

$$\theta_{\max} = 29,4^\circ$$

$$h = 0 \rightarrow 6$$

$$k = 0 \rightarrow 6$$

$$l = -7 \rightarrow 7$$

2 réflexions de référence

fréquence: 120 min

variation d'intensité: 3%

Affinement

Affinement à partir des F^2

$$R[F^2 > 2\sigma(F^2)] = 0,017$$

$$wR(F^2) = 0,051$$

$$S = 1,26$$

134 réflexions

13 paramètres

$$w = 1/[\sigma^2(F_o^2) + (0,0146P)^2 + 0,0904P] \text{ where } P = (F_o^2 + 2F_c^2)/3$$

$$(\Delta/\sigma)_{\max} < 0,001$$

$$\Delta\rho_{\max} = 0,16 \text{ e \AA}^{-3}$$

$$\Delta\rho_{\min} = -0,23 \text{ e \AA}^{-3}$$

Correction d'extinction:

SHELXL97 (Sheldrick, 1997)

Coefficient d'extinction: 0,52 (6)

Tableau 1

Paramètres géométriques (\AA , $^\circ$).

Si—O ⁱ	1,6769 (4)	Li—O ⁱ	2,0579 (15)
Code de symétrie: (i) $1+x-y, 1-y, 1-z$.			

Le modèle désordonné a été affiné en utilisant les outils disponibles sous *SHELXL97* (Sheldrick, 1997).

Collection des données: *CAD-4 EXPRESS* (Duisenberg, 1992; Maciček & Yordanov, 1992); affinement des paramètres de la maille: *CAD-4 EXPRESS*; réduction des données: *MolEN* (Fair, 1990); programme(s) pour la solution de la structure: *SHELXS97* (Sheldrick, 1997); programme(s) pour l'affinement de la structure: *SHELXL97* (Sheldrick, 1997); graphisme moléculaire: *DIAMOND* (Brandenburg, 1998) and *PLATON* (Spek, 2003); logiciel utilisé pour préparer le matériel pour publication: *SHELXL97*.

Références

- Beall, G. H. (1994). *Industrial Applications of Silica*. Dans *Silica: Physical Behavior, Geochemistry, and Materials Applications*, édité par P. J. Heaney, C. T. Prewitt et G. V. Gibbs, *Reviews in Mineralogy*, Vol. 29, pp. 469–505. Washington, D. C.: Mineralogical Society of America.
- Brandenburg, K. (1998). *DIAMOND*. Version 2.0. Université de Bonn, Allemagne.
- Duisenberg, A. J. M. (1992). *J. Appl. Cryst.* **25**, 92–96.
- Fair, C. K. (1990). *MolEN*. Enraf-Nonius, Delft, Les Pays-Bas.
- International Tables for Crystallography* (1992). Vol. C, Tables 4.2.6.8 and 6.1.1.4. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
- Lichtenstein, A. I., Jones, R. O., Xu, H. & Heaney, P. J. (1998). *Phys. Rev. B*, **58**, 6219–6223.
- Maciček, J. & Yordanov, A. (1992). *J. Appl. Cryst.* **25**, 73–80.
- Mueller, G., Paulus, H. & Stiefel, J. (1990). *Neues Jahrb. Miner. Monatsh.* **11**, 493–503.
- North, A. C. T., Phillips, D. C. & Mathews, F. S. (1968). *Acta Cryst. A*, **24**, 351–359.
- Qi, F., Diezemann, G., Böhm, H., Lambert, J. & Böhmer, R. (2004). *J. Magn. Resonance*, **169**, 225–239.
- Sartbaeva, A., Redfern, S. A. T. & Lee, W. T. (2004). *J. Phys. Condens. Matter*, **16**, 5267–5278.
- Sheldrick, G. M. (1997). *SHELXS97* and *SHELXL97*. Université de Göttingen, Allemagne.
- Shin-ichi, F., Satoshi, S., Kaduhiro, S. & Hitoshi, T. (2004). *Solid State Ionics*, **167**, 325–329.
- Spek, A. L. (2003). *J. Appl. Cryst.* **36**, 7–13.
- Sprengard, R., Binder, K., Brandle, M., Fotheringham, U., Sauer, J. & Pannhorst, W. (2000). *J. Non-Cryst. Solids*, **274**, 264–270.
- Tscherry, V., Schulz, H. & Laves, F. (1972). *Z. Kristallogr.* **135**, 161–174.
- Xu, H., Heaney, P. J. & Beall, G. H. (2000). *Am. Mineral.* **85**, 971–979.
- Xu, H., Heaney, P. J., Navrotsky, A., Topor, L. & Liu, J. (1999). *Am. Mineral.* **84**, 1360–1369.